

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина" □

# РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе аспирантуры

**11.06.01**

11.06.01 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Направленность программы: Вакуумная и плазменная электроника

Кафедра: Промышленной электроники

Факультет: Факультет электроники

Квалификация:

Форма обучения: Очная форма

Срок получения образования: 4 г.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2020

Учебный год 2023-2024

Образовательный стандарт (ФГОС) № 876 от 30.07.2014

-	-	-	-	Форма контроля			з.е.		Итого акад.часов							Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4		Курс 5		Закрепленная кафедра		
				Экспертное	Факт	Экспертное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	СР	Конт роль	Пр. подгот	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	Код	Наименование	
Считать в плане	Индекс	Наименование	Блок/часть	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	Экспертное	Факт	Экспертное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	СР	Конт роль	Пр. подгот	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	Код	Наименование		
<b>Блок 2.Практики</b>							6	6	216	216			207.25	8.75	203.75													
<b>Вариативная часть</b>							6	6	216	216			207.25	8.75	203.75													
+	Б2.В.01(П)	Научно-исследовательская практика	Б2.В			7	6	6	216	216			207.25	8.75	203.75										1	Промышленной электроники		
<b>Блок 3.Научные исследования</b>							189	189	6804	6804	0.5	0.5	6768.5	35	6635	25	23	23	19	27	27	24	21					
<b>Вариативная часть</b>							189	189	6804	6804	0.5	0.5	6768.5	35	6635	25	23	23	19	27	27	24	21					
+	Б3.В.01(Н)	Научно-исследовательская деятельность	Б3.В			246	144	144	5184	5184	0.5	0.5	5157.25	26.25	5037.25	25	23	23	19	27	27			1	Промышленной электроники			
+	Б3.В.02(Н)	Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук	Б3.В			8	45	45	1620	1620			1611.25	8.75	1597.75							24	21	1	Промышленной электроники			
<b>Блок 4.Государственная итоговая аттестация</b>							9	9	324	324			234.85	89.15														
<b>Базовая часть</b>							9	9	324	324			234.85	89.15														
+	Б4.Б.01	Государственная итоговая аттестация	Б4.Б																									
+	Б4.Б.02	Государственный экзамен	Б4.Б	8			3	3	108	108			72.5	35.5										1	Промышленной электроники			
+	Б4.Б.03	Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)	Б4.Б	8			6	6	216	216			162.35	53.65									6		1	Промышленной электроники		
<b>К.М.Комплексные модули</b>							9	9	324	324	108.95	108.95	82.95	132.1				1	2	3	3							
+	К.М.01	<b>Комплексный модуль 1</b>	<b>К.М</b>	<b>456</b>	<b>6</b>		9	9	324	324	<b>108.95</b>	<b>108.95</b>	<b>82.95</b>	<b>132.1</b>				1	2	3	3							
+	К.М.01.01	Специальная дисциплина по направлению подготовки "Физика и астрономия"	Б1.Б	4			3	3	108	108	48.35	48.35	24.35	35.3				1	2					1	Промышленной электроники			
+	К.М.01.02(К)	Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с научной специальностью "Вакуумная и плазменная электроника"	Б1.В	6			1	1	36	36			1	35							1			1	Промышленной электроники			
+	К.М.01.ДВ.01	<b>Дисциплина по выбору 2</b>	<b>Б1.В</b>	<b>5</b>			3	3	108	108	<b>34.35</b>	<b>34.35</b>	<b>20.35</b>	<b>53.3</b>						3								
+	К.М.01.ДВ.01.01	Техника высоких напряжений	Б1.В	5			3	3	108	108	34.35	34.35	20.35	53.3						3				1	Промышленной электроники			
-	К.М.01.ДВ.01.02	Сильноточная электроника	Б1.В	5			3	3	108	108	34.35	34.35	20.35	53.3					3					1	Промышленной электроники			
+	К.М.01.ДВ.02	<b>Дисциплина по выбору 3</b>	<b>Б1.В</b>	<b>6</b>			2	2	72	72	<b>26.25</b>	<b>26.25</b>	<b>37.25</b>	<b>8.5</b>						2								
+	К.М.01.ДВ.02.01	Моделирование ионных взаимодействий	Б1.В	6			2	2	72	72	26.25	26.25	37.25	8.5						2				1	Промышленной электроники			
-	К.М.01.ДВ.02.02	Моделирование электронных взаимодействий	Б1.В	6			2	2	72	72	26.25	26.25	37.25	8.5						2				1	Промышленной электроники			

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО  
ЗАВЕДУЮЩИМ  
КАФЕДРОЙ

**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

**19.06.23** 14:38  
(MSK)

Простая подпись

ПОДПИСАНО  
НАЧАЛЬНИКОМ УОНИ

**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Кусакин Дмитрий Сергеевич, Начальник УОНИ

**19.06.23** 15:50  
(MSK)

Простая подпись

ПОДПИСАНО  
ПРОРЕКТОРОМ ПО НР

**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Гусев Сергей Игоревич, Проректор по научной работе и инновациям

**19.06.23** 15:52  
(MSK)

Простая подпись